

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2005 年 10 月 13 日 (13.10.2005)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2005/095275 A1

- (51) 国際特許分類: C01B 31/02
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2005/006441
- (22) 国際出願日: 2005 年 3 月 25 日 (25.03.2005)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願2004-097875 2004 年 3 月 30 日 (30.03.2004) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東海カーボン株式会社 (TOKAI CARBON CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1078636 東京都港区北青山一丁目 2 番 3 号 Tokyo (JP). 双葉電子工業株式会社 (FUTABA CORPORATION) [JP/JP]; 〒2978588 千葉県茂原市大芝 6 2 9 Chiba (JP).
- (72) 出願人 および
- (72) 発明者: 滝川 浩史 (TAKIKAWA, Hirofumi) [JP/JP]; 〒4418066 愛知県豊橋市王ヶ崎町字上原 1 番地の 3 (1-104) Aichi (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 近藤 明 (KONDO, Akira) [JP/JP]; 〒1078636 東京都港区北青山一丁目 2 番 3 号 東海カーボン株式会社内 Tokyo (JP). 吉川 和男 (YOSHIKAWA, Kazuo) [JP/JP]; 〒1078636 東京都港区北青山一丁目 2 番 3 号 東海カーボン株式会社内 Tokyo (JP). 伊藤 茂生 (ITO, Shigeo) [JP/JP]; 〒2978588 千葉県茂原市大芝 6 2 9 双葉電子工業株式会社内 Chiba (JP).
- (74) 代理人: 福田 保夫, 外 (FUKUDA, Yasuo et al.); 〒1010041 東京都千代田区神田須田町 1-16 本郷ビル 5 階 Tokyo (JP).

[続葉有]

(54) Title: CARBON NANOBALLOON STRUCTURE AND METHOD FOR PREPARATION THEREOF, AND ELECTRON RELEASING ELEMENT

(54) 発明の名称: カーボンナノバルーン構造体とその製造方法および電子放出素子



(57) Abstract: A carbon nanoballoon structure having a hollow structure of a relatively large closed space, characterized in that it comprises a hollow structure wherein graphite layers are bound and arranged in such a manner that they form a curved surface as a whole; and a method for preparing the carbon nanoballoon structure with ease and stability, which comprises heating a soot formed by an arc discharge using a carbon electrode or by the laser irradiation to a carbon material or heating a carbon black having a specific surface area of 1000 m<sup>2</sup>/g or more and a primary particle diameter of 20 nm or more, to a high temperature in an inert gas atmosphere.

(57) 要約: 比較的大きな閉空間を有する中空構造を有するカーボンナノバルーン構造体、およびこのような構造体を容易且つ安定的に得るカーボンナノバルーン構造体の製造方法を提供するものであり、炭素電極を用いたアーク放電により発生した煤または炭素へのレーザー照射により蒸発した煤、または比表面積が 1000 m<sup>2</sup>/g 以上で、一次粒子径が 20 nm 以上のカーボンブラックを、不活性ガス雰囲気中で高温加熱することにより得られ、グラファイト層が結合して全体として曲面を形成するよう配置された中空構造からなることを特徴とする。

WO 2005/095275 A1



(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ,

BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

## 明細書

## カーボンナノバルーン構造体とその製造方法および電子放出素子

## 技術分野

本発明は、中空構造を有するカーボンナノバルーン構造体とその製造方法および電子放出素子に関する。

## 背景技術

不活性雰囲気中での黒鉛電極のアーク放電や炭素へのレーザー照射などによって炭素を気化させ、徐冷し凝集させることにより得られる煤には、ナノメートルスケールの微細構造を有する炭素物質、いわゆるフラーレンスートが含まれており、フラーレンスートの形態としては、 $C_{60}$ に代表される単層球形、内部に小さな空隙を有する多層球形（カーボンナノ粒子）、アーク放電において黒鉛にある種の金属触媒を混合して気化する際に煤の中に含まれる単層チューブ形（単層カーボンナノチューブ）、単層ナノチューブが同心的に数層重なった構造をそなえた多層チューブ形（多層カーボンナノチューブ：金属触媒を混合していない黒鉛を用いた場合に陰極表面に堆積する）があることが知られている。

これらの炭素物質は新しい材料分野への応用が期待されており、従来、その製造技術として、炭化水素、芳香族油など炭素含有化合物を不完全燃焼または熱分解して得られる煤状炭素、例えばカーボンブラックに電子線、ガンマ線、X線などの高エネルギービームを照射してナノサイズの真球状黒鉛を得る方法（特開2001-48508号公報参照）、固体状炭素単体物質、例えば焼結炭素に、不活性ガス雰囲気中で、レーザー光を照射して炭素を蒸発させ、得られた煤状物質を溶媒に懸濁して分散させ、ついで単一または複数個が集合した球状粒子を回収することにより単層カーボンナノホーン構造体を得る方法（特開2001-64004号公報参照）が提案されている。また、5～10気圧の不活性ガス雰囲気中で、炭素に炭酸ガスレーザーを照射することにより1000℃以上に加熱されたクラスター状の炭素を発生させてナノグラファイト球状体を得る方法（特開2

003-206120号公報参照)なども提案されている。

上記の方法で得られるものは、いずれも中実構造もしくは内部に微細な空隙が存在する構造のものであり、光吸収材、超硬度材料、水素貯蔵体、メタンガス貯蔵体、ガス改質材、研磨材、潤滑材、その他の新規機能材として期待されているが、さらに大きな内部空間を有するナノサイズの中空炭素構造体を得ることができれば、外殻部を構成するグラファイト構造と内部の中空構造をそなえた構造的特徴によって、さらに多くの製品分野への応用を期待することが可能となる。

中空構造をそなえたナノサイズの炭素構造体を得る方法として、二酸化炭素および水素を含む混合ガスを450～750℃の反応温度で、金属微粒子を含む遷移金属触媒に接触させ、二酸化炭素を接触水素還元することにより、金属微粒子を内包するカーボンナノカプセルを製造する方法(特開2000-344506号公報参照)や、マイクロ波によって発生されるグロー放電プラズマに、炭素を含む原料ガスを供給して分解し、外径100nm以上のカーボンナノカプセルを製造する方法(特開2003-81619号公報参照)が提案されているが、前者は中空構造内に金属を内包するものであり、後者も、C<sub>60</sub>の微粒子を内包させ、これをディスクに接着して記録媒体を製造したり、発光材料や光学材料を閉じ込めるためのもので、完全な閉空間を有する中空体ではない。またアーク放電法により稀に、数層から数十層のグラファイトが入れ子構造状に積み重なる多面体構造を持つカーボンポリヘドロンが得られるが(C h e m. P h y s. L e t t. 204, 227 (1993) 参照)、カーボンポリヘドロンは内部が中空でないものもあり、また粒子径が数nmから大きくても数十nmであるため、多くの物質を内蔵することはできない。従って、大きな内部空間を有するナノサイズの中空炭素中空体を効率的且つ安定的に得る手法は実用化されていないのが現状である。

#### 発明の開示

発明者らは、大きな内部空間を有するナノサイズの中空炭素構造体を得ることを目的とする試験、検討の過程において、炭素電極を用いたアーク放電で発生した煤、または炭素をレーザー照射することにより蒸発させた煤を観察したところ、

第1図に示すような繭玉状の炭素が存在すること、これを不活性ガス雰囲気中で高温に加熱すると、自己組織化によって、第2図に示すような球形状、ひょうたん形状、三角おむすび形状など、種々の形状を有する中空構造のカーボンナノバルーンが得られることを見出した。

本発明は、上記の知見に基づいてなされたものであり、その目的は、比較的大きな閉空間をそなえた中空構造を有するカーボンナノバルーン構造体、およびこのような構造体を容易且つ安定的に得るカーボンナノバルーン構造体の製造方法を提供することにある。本発明はまた、このようなカーボンナノバルーン構造体の好適な適用例として、電子放出特性に優れた電子放出素子を提供することを目的とする。

上記の目的を達成するための本発明によるカーボンナノバルーン構造体は、グラファイト層が結合して全体として曲面を形成するよう配置された中空構造からなり、その直径が20～500nmであることを特徴とする。但し、直径とは、構造体の中心を通るようにX軸をとり、該中心を通り且つX軸に直交するようY軸をとり、構造体のX軸方向の長さY軸方向の長さの平均をいう。

また、上記カーボンナノバルーン構造体において、グラファイト層が1～30層であること、および／または、空隙率が30～99%であることを特徴とする。但し、空隙率は、構造体の中心部を通るようにX軸をとり、該中心を通り且つX軸に直交するようY軸をとり、構造体のX軸方向の長さY軸方向の長さの平均を構造体の直径とし、球形に近似して構造体の体積を求め、該構造体の直径からグラファイト層の厚さの2倍を引いた値を空隙部の直径とし、球形に近似して空隙部の体積を求め、 $(\text{空隙部の体積} / \text{構造体の体積}) \times 100\%$ を計算して求める。

さらに、上記カーボンナノバルーン構造体のいずれかにおいて、前記構造体が空隙部まで達する開口部が設けられたものであることを特徴とする。

本発明によるカーボンナノバルーン構造体の製造方法は、炭素電極を用いたアーク放電により発生した煤または炭素へのレーザー照射により蒸発した煤、または比表面積が $1000\text{ m}^2/\text{g}$ 以上、一次粒子径が20nm以上のカーボンブラックを、不活性ガス雰囲気中で高温加熱することを特徴とする。

また、上記カーボンナノバルーン構造体の製造方法において、炭素電極を用いたアーク放電または炭素へのレーザー照射を、窒素雰囲気、酸素雰囲気、水素雰囲気、または窒素、酸素および水素のうちの2種以上のガスの混合雰囲気中で行い、発生した煤の一部にカーボンナノホーンを含むことを特徴とする。

本発明による電子放出素子は、引き出し電極と、該引き出し電極に近接して配置されたエミッタ材料を有するカソード電極の間に電界を印加して電界電子放出を行う電子放出素子において、前記エミッタ材が上記カーボンナノバルーン構造体のいずれかを含んでなることを特徴とする。

本発明によれば、比較的大きな閉空間をそなえた中空構造を有するカーボンナノバルーン構造体、およびこのような構造体を容易且つ安定的に得るカーボンナノバルーン構造体の製造方法が提供される。本発明によるカーボンナノバルーン構造体は、外殻部が黒鉛（グラファイト）構造であるため電気伝導性に優れ、潤滑性が良好であり、耐熱性が高く、化学的に安定で、耐薬品性に優れている。また、内部は中空構造であるため嵩密度が低く、断熱性に優れている。

#### 図面の簡単な説明

第1図は、炭素電極を用いたアーク放電で発生した煤、または炭素をレーザー照射することにより蒸発させた煤中に存在する繭玉状の炭素を示す透過型電子顕微鏡（TEM）写真である。

第2図は、第1図の煤を高温加熱して生じた構造体、すなわち、グラファイト層（黒鉛層）が結合して全体として曲面を形成するよう配置され、全体としてまたは部分的に球形状、ひょうたん形状、三角おむすび形状など、種々の形状を有する中空構造のカーボンナノバルーン構造体を示すTEM写真である。

第3図は、第1図の煤を高温加熱する前のTEM写真である。グラファイト層は認められず、内部は中実である。なお、第3図と第1図は同一サンプルであり、第3図は第1図の低倍率観察写真である。

第4図は、第1図の煤を1750℃で加熱した後のTEM写真である。約20%の粒子の外郭部にグラファイト層の形成が認められるが、内部は依然中実である。

第5図は、第1図の煤を2000℃で加熱した後のTEM写真である。約80%の粒子の外郭部にグラファイト層の形成が認められ、内部の中空化も進みはじめている。

第6図は、第1図の煤を2400℃で加熱した後のTEM写真である。ほぼ全ての粒子の外郭部にグラファイト層の形成が認められ、内部もほぼ中空化している。

第7図は、第1図の煤を2800℃で加熱した後のTEM写真である。ほぼ全ての粒子の外郭部にグラファイト層の形成が認められ、内部もほぼ中空化している。なお、第7図と第2図は同一サンプルであり、第7図は第2図の低倍率観察写真である。

第8図は、酸化処置により開口部が形成されたカーボンナノバルーン構造体のTEM写真である。

第9図は、第8図のTEM写真を模式化した図である。

第10図は、本発明のカーボンナノバルーン構造体を電子放出材料とする電子放出装置の一実施例を示す断面図である。

第11図は、本発明のカーボンナノバルーン構造体を電子放出材料とする電子放出装置の他の実施例を示す断面図である。

第12図は、本発明のカーボンナノバルーン構造体を電子放出材料として使用して電子放出素子（電子放出源）としての電子放出特性を測定するための装置の概略を示す図である。

第13図は、第12図の測定装置を用いて測定された本発明のカーボンナノバルーン構造体の電圧（V）－電流（I）特性を示すグラフである。

第14図は、第12図の測定装置を用いて測定された本発明のカーボンナノバルーン構造体のFowler-Nordheim（F-N）プロットである。

第15図は、市販のカーボンブラック（東海カーボン（株）製、シーストS）を2800℃で加熱した後のTEM写真であり、内部まで中実なグラファイト層を有する中実構造が形成されているのが認められる。

第16図は、市販のカーボンブラック（旭カーボン（株）製、アサヒサーマル）を2800℃で加熱した後のTEM写真であり、内部まで中実なグラファイト

層を有する中実構造が形成されているのが認められる。

#### 発明を実施するための最良の形態

本発明のカーボンナノバルーン構造体は、炭素電極、好ましくは黒鉛電極を用いたアーク放電で発生した煤、または炭素、好ましくは黒鉛をレーザー照射することにより蒸発させた煤、または比表面積が  $1000 \text{ m}^2/\text{g}$  以上、一次粒子径が  $20 \text{ nm}$  以上のカーボンプラックを、窒素や、アルゴン、ヘリウムなどの希ガスからなる不活性ガス雰囲気において高温加熱することにより製造され、第2図に示すように、球形状、ひょうたん形状、三角おむすび形状（三角形状で三つの先端部が円弧状のもの）など、種々の形状を有する中空構造のナノサイズのバルーン構造体を得られる。第2図からわかるように、カーボンナノバルーン構造体は、TEM写真中の濃い領域で示される黒鉛構造からなる外郭部1と、TEM写真中の該濃い領域で囲まれた薄い領域で示される内部の中空部2から構成されている。そして、カーボンナノバルーン構造体が複数個接合してストラクチャーを構成している。さらに、巨視的にみると、これらが集合して粉体を構成している。なお、第2図のTEM写真については、わかり易いように引き出し線と数字を追加してある。

炭素電極を用いたアーク放電で発生した煤、または炭素をレーザー照射することにより蒸発させた煤中には、前記のように、カーボンナノバルーン構造体の前駆体となる第1図に示すような繭玉状の炭素が存在するが、この前駆体の合成雰囲気としては、窒素雰囲気、酸素雰囲気、水素雰囲気、または窒素、酸素および水素のうちの2種以上のガスの混合雰囲気が好ましく、当該雰囲気中で、炭素電極を用いたアーク放電または炭素へのレーザー照射を行うことにより前駆体を得られ、また発生した煤の一部には前記のカーボンナノホーンが含まれたものとなる。雰囲気ガスを窒素または水素とすると合成される煤の量が多くなり、また酸素とすると合成時に混入するカーボン片などのゴミをある程度取り除くことができる。

前記繭玉状の炭素が高温加熱によりカーボンナノバルーン構造体に変化する現象に着目して、同様の現象が得られるカーボン材料について試験、検討を行った



結果、比表面積が  $1000 \text{ m}^2 / \text{g}$  以上、一次粒子径が  $20 \text{ nm}$  以上のカーボンブラックを不活性ガス雰囲気中で高温加熱した場合、同様の構造を有するカーボンナノバルーン構造体に変化することが見出された。市販のカーボンブラックではケッチェンブラックがこれに該当する。

炭素電極を用いたアーク放電で発生した煤を、不活性ガス雰囲気中で高温加熱する場合の加熱温度を変えて、繭玉状の炭素がカーボンナノバルーン構造体に変化して行く過程を透過型電子顕微鏡 (TEM) で観察した結果は第3～7図のとおりである。第3図は高温加熱する前の繭玉状の炭素を示すものであり、グラファイト層は認められず、内部は中実である。なお、第3図と第1図とは同一サンプルであり、第3図は第1図の低倍率観察写真である。第4図は  $1750^\circ\text{C}$  に加熱処理したもので、約  $20\%$  の粒子の外郭部にグラファイト層の形成が認められるが、内部は依然中実である。第5図は  $2000^\circ\text{C}$  で加熱処理したもので、約  $80\%$  の粒子の外郭部にグラファイト層の形成が認められ、内部の中空化が進みはじめている。

第6図は  $2400^\circ\text{C}$  で加熱処理したもので、ほぼ全ての粒子の外郭部にグラファイト層の形成が認められ、内部もほぼ中空化している。第7図は  $2800^\circ\text{C}$  で加熱処理したもので、第6図と同様、ほぼ全ての粒子の外郭部にグラファイト層の形成が認められ、内部もほぼ中空化している。なお、第7図と第2図は同一サンプルであり、第7図は第2図の低倍率写真である。従って、カーボンナノバルーン構造体を得るための高温加熱温度は  $2000^\circ\text{C}$  以上が好ましく、より好ましくは  $2400^\circ\text{C}$  以上であることが見出された。

炭素電極を用いたアーク放電で発生した煤、炭素をレーザー照射することにより蒸発させた煤の中には、前記のカーボンナノホーン類なども含まれるが、試験の結果、不活性ガス雰囲気中での高温加熱処理前後の重量変化がほとんどなかったことから、明らかに合成時に混入したカーボン片などのゴミ以外は、不活性ガス雰囲気中での高温加熱によりカーボンナノホーン類も含めて全てナノバルーン構造体に変化することが確認された。

上記の方法により得られるカーボンナノバルーン構造体は、グラファイト層（黒鉛層）が曲面を形成するよう配置され、全体としてまたは部分的に、前記のよ

うに、球形状、ひょうたん形状、三角おむすび形状など、種々の形状を有する中空構造となる。

グラファイト層は1～30層の単層または複数層からなり、カーボンナノバルーン構造体の直径は20～500nmである。また、中空構造の空隙率は30～99%であり、直径とは、構造体の中心部を通るようにX軸をとり、該中心を通り且つX軸に直交するようY軸をとり、構造体のX軸方向の長さY軸方向の長さの平均値として求めた値であり、空隙率は、この直径から球形に近似して構造体の体積を求め、構造体の直径からグラファイト層の厚さの2倍を引いた値を空隙部の直径とし、球形に近似して空隙部の体積を求め、(空隙部の体積/構造体の体積)×100%を計算して求める。

本発明においては、製造条件を変えることにより、カーボンナノバルーン構造体が2個以上接合した形態のものからなる構造体、あるいはこの形態のものを含む構造体で、DBP吸油量で30～500ml/100gのストラクチャー構造のものを得ることもできる。

本発明によるカーボンナノバルーン構造体を、カプセルとして利用する場合には、構造体に空隙部まで達する開口部を設ける。開口部を設ける手法としては、カーボンナノチューブ、カーボンナノホーン、フラーレン類に穴を開ける手法として一般的に用いられる酸素を含む雰囲気中で酸化処理する方法を用いるのがよい。

具体的には、酸素を含む雰囲気中で、400～700℃、好ましくは600℃前後の温度(550～650℃)で酸化処理するのが望ましく、この範囲の温度で酸化処理することによって、炭素原子1個分に相当する0.1nm～50nmの開口部が形成される。開口部が形成されたカーボンナノバルーン構造体の透過型電子顕微鏡(TEM)観察結果を第8図に、その模式図を第9図にそれぞれ示した。400℃未満では酸化が進行せず穴が開かない場合があり、700℃を越える温度で処理するとバルーン構造が焼失し易くなる。

本発明によるカーボンナノバルーン構造体は、前記のように、とくに電子放出素子(電界電子放出素子)として好適に使用し得る特性をそなえている。以下、その実施形態を図面により説明する。第10図は、電子放出素子を有する電子放

出装置の一実施例を示す断面図である。第10図において、ガラス基板101と、ガラス基板102と、両基板の周囲を封着するガラスの側面板103から真空容器100が構成される。ガラス基板101の上には、第1電極としてカソード電極104が、アルミニウムなどの金属の蒸着などにより形成され、カソード電極104上には、電子放出材料（エミッタ材料）105の層が形成されている。電子放出材料105は、本発明のカーボンナノバルーン構造体からなり、カソード電極104上に例えばペーストとして塗布形成する。なお、カソード電極104と電子放出材料105の層は一体に形成することができる。

また、ガラス基板101に対向するガラス基板102の上には、電子放出材料105に対向（近接）して、第2の電極（引き出し電極）としてのアノード電極106が、アルミニウムなどの金属の蒸着などにより形成されている。アノード電極106の上には、 $ZnO:Zn$ などの蛍光体層107がスクリーン印刷法などにより形成されている。

上記2極管構造の電子放出装置において、カソード電極104とアノード電極106の間に電圧を印加すると、カソード電極104に接続された上記本発明のカーボンナノバルーン構造体からなる電子放出材料105から電子が放出される。放出された電子は、アノード電極106に引き寄せられ、蛍光体層107に射突して光を放出する。この時、カーボンナノバルーン構造体は、粒径が揃っており曲率半径が揃っているため、電圧を印加した際に電界強度をほぼ均一に揃え易い。

第11図は、電子放出装置の他の実施例を示す断面図である。なお、第10図と同一の部材については同一の符号を付した。第10図に示す装置と異なるのは、ガラス基板101の上に、電子放出材料105に対向（近接）して、第2の電極（引き出し電極）として金属メッシュからなるグリッド電極108が形成されている点である。

上記3極管構造の電子放出装置において、カソード電極104とグリッド電極（ゲート電極）108の間に電圧を印加すると、カソード電極104に接続された前記本発明のカーボンナノバルーン構造体からなる電子放出材料105から電子が放出される。放出された電子は、アノード電極106に引き寄せられ、蛍光体層107に射突して光を放出する。この時、カーボンナノバルーン構造体は、

粒径が揃っており曲率半径が揃っているため、電圧を印加した際に電界強度をほぼ均一に揃え易い。

電子放出源としてのカーボンナノバルーン構造体の電子放出特性の測定結果を以下に説明する。第12図は、本発明のカーボンナノバルーン構造体を電子放出材料として使用した電子放出装置において、その電子放出特性を測定するための装置である。

第12図に示すように、測定装置の真空チャンバー200内に、ガラスからなるカソード基板201と同じくガラスからなるアノード基板202を対向配置し、カソード基板201の上には、ITOからなるカソード電極203と本発明のカーボンナノバルーン構造体204含むエミッタ層を形成し、アノード基板202の上には、アルミニウムからなるアノード電極（兼引き出し電極）205を形成する。

カソード基板201とアノード基板202の間の距離を $50\mu\text{m}$ に設定し、カソード電極203とアノード電極205の間には、直流電源206と電流計207を直列接続してカーボンナノバルーン構造体204を電子放出材料として使用し、電子放出素子（電子放出源）としての電子放出特性を測定した。結果を第13図および第14図（図中、CNBはカーボンナノバルーン構造体）に示す。

第13図は、電圧（V）－電流（I）特性の評価結果を示し、第14図は、そのFowler-Nordheim（F-N）プロットを示す。第13～14図にみられるように、電子放出源から電界電子放出が行われているのが確認される。

つぎに、本発明のカーボンナノバルーン構造体をガス吸蔵材として適用する場合を説明する。この場合には、まず、容器の内部に特定ガス（水素、窒素、その他のガス、またはそれらの混合ガス）を導入して残留させておく。ついで、その容器の内部の特定ガス雰囲気中にカーボンナノバルーン構造体を導入して加熱または加圧する。すなわち、熱的・機械的な処理により、前記特定ガスをカーボンナノバルーン構造体の中空部（内壁表面を含む）に導入し、必要に応じて、加熱または加圧などを通じて特定ガスを中空部から外郭部の外へ排出する。このように、カーボンナノバルーン構造体の中空部に導入した特定ガスの導入、排出を行うことによりガス吸蔵材としての利用が可能となる。なお、上記手法では、特定

ガスのカーボンナノバルーン構造体への導入を、カーボンナノバルーン構造体の製造後に行う場合について説明したが、特定ガスの導入はカーボンナノバルーン構造体の製造中に行うこともできる。また、特定ガスは、カーボンナノバルーン構造体が集合した粒子の空隙に導入してもよい。

## 実施例

以下、本発明の実施例を比較例と対比して説明し、その効果を立証する。なお、これらの実施例は本発明の一実施態様であり、本発明はこれに限定されるものではない。

### 実施例 1

2本の黒鉛電極を窒素雰囲気中でアーク放電した際に発生した煤を、タンマン炉を用いて、アルゴンガス雰囲気において、2800℃の温度で1時間加熱した。得られた煤を、透過型電子顕微鏡（TEM）で観察したところ、複数のグラファイト層が結合して全体として曲面を形成するよう配置され、全体としてまたは部分的に、球形状、ひょうたん形状、三角おむすび形状など、種々の形状を有する中空構造となっているのが認められた。おおよそ70%以上の粒子において、グラファイト層の数は10～16層、構造体の直径は30～100nm、中空部の空隙率は45～80%であった。なお、最大長径は500nm、最小短径は20nmであった。構造体中には、2個以上の構造体が接合しているものもあり、ストラクチャーの発達度合を示すDBP吸油量は約100ml/100gであった。

また、2本の黒鉛電極を酸素雰囲気中でアーク放電して発生した煤を、アルゴン雰囲気中2800℃で加熱処理した場合にも、同様なナノバルーン構造体を得られた。酸素雰囲気中でアーク放電した場合は、煤の発生量は少ないが、合成時に混入するカーボン片などのゴミの量は少なかった。水素雰囲気中でアーク放電して発生した煤を、アルゴン雰囲気中2800℃で加熱処理しても、同様なナノバルーン構造体を得られた。水素雰囲気中でアーク放電した場合と窒素雰囲気中でアーク放電した場合で、得られるナノバルーン構造体にほとんど差はなかった。さらに、窒素と酸素を8：2の割合で混合した雰囲気中でアーク放電して発生した煤を、アルゴン雰囲気中2800℃で加熱しても、同様なナノバルーン構造体

が得られた。窒素のみでアーク放電した場合と比べて、カーボン片などのゴミがやや少なかった。このように、アーク放電における雰囲気、窒素雰囲気、酸素雰囲気、水素雰囲気、または窒素、酸素、水素のうちの1種以上のガスの混合雰囲気と変えた場合でも、発生する煤をアルゴン雰囲気中2800℃で加熱処理することにより同様のナノバルーン構造体を得られることが確認された。炭素へのレーザー照射により発生する煤についても、同様に雰囲気を変えた試験を実施し、アーク放電の場合と同一結果であることを確認した。高温加熱処理時の不活性ガスをアルゴンからヘリウムに変えても結果は変わらなかった。

#### 実施例 2

市販のケッチェンブラック（ケッチェンブラック・インターナショナル（株）製、ケッチェンブラックEC-600JD）を、タンマン炉を用いて、アルゴンガス雰囲気において、2800℃の温度で1時間加熱した。得られた煤を、TEMで観察したところ、おおよそ70%以上の粒子において、グラファイト層の数8～14層、直径30～50nm、空隙率40～75%であるカーボンナノバルーン構造体を得られた。

#### 実施例 3

実施例1で得られたカーボンナノバルーン構造体を、空気雰囲気中において、600℃で1時間酸化処理した。比表面積は、酸化処理前の35m<sup>2</sup>/gに対して70m<sup>2</sup>/gであり、比表面積が2倍になっていることから、構造体に内部の中空部まで通じる開口部が設けられていることが確認できる。酸化処理した構造体をTEMで観察したところ、開口部の直径は5～20nmであった。

#### 比較例 1

市販のカーボンブラック（東海カーボン（株）製、シーストS）を、タンマン炉を用いて、アルゴンガス雰囲気中において、2800℃の温度で1時間加熱した。得られた煤をTEMで観察したところ、第15図に示すように、内部まで中実なグラファイト層を有する中実構造体が形成されているのが認められた。

#### 比較例 2

市販のカーボンブラック（旭カーボン（株）製、アサヒサーマル）を、タンマン炉を用いて、アルゴンガス雰囲気中において、2800℃の温度で1時間加熱

した。得られた煤をTEMで観察したところ、第16図に示すように、内部まで中実なグラファイト層を有する中実構造体が形成されているのが認められた。

#### 比較例 3

2本の金属触媒入り黒鉛電極をアーク放電させてカーボンナノチューブを得た。得られたカーボンナノチューブを、タンマン炉を用いて、アルゴンガス雰囲気中において、2800℃の温度で1時間加熱したが、TEM観察の結果、加熱前と比べて構造の変化は認められなかった。

#### 比較例 4

実施例1で得られたカーボンナノバルーン構造体を、空気雰囲気中において、350℃で1時間酸化処理した。比表面積は、酸化処理前の $35\text{ m}^2/\text{g}$ に対して、同じく $35\text{ m}^2/\text{g}$ であり、比表面積が同じであることから、構造体には中空部まで通じる開口部が形成されていないことが確認できる。酸化処理した構造体をTEMで観察したところ、処理前後における構造の変化が認められなかった。

#### 比較例 5

実施例1で得られたカーボンナノバルーン構造体を、空気雰囲気中において、750℃で1時間酸化処理した。酸化処理した構造体をTEMで観察したところ、カーボンナノバルーン構造体の破片が観察されたのみであり、構造体の大半は焼失していた。

#### 産業上の利用可能性

本発明によるカーボンナノバルーン構造体は、例えば酸化処理によって内部の中空部に通じる開口部を設けることができるのでカプセルとして利用することができる。バルーン構造が2個以上接合してストラクチャーを形成しているものもあり、複合材用フィラーとして良電気伝導性や補強効果も期待することもできる。

本発明によるカーボンナノバルーン構造体の用途例としては、一次電池、二次電池、燃料電池などの電池電極材料、電子放出素子、ガス貯蔵装置、ガス・液体浄化装置、ガス・液体改質装置、ゴム・樹脂（プラスチック）・ウレタン・エラストマー添加剤、潤滑剤、研磨剤、切削剤、光吸収材、ペースト、化粧品、薬剤などのカプセルなどが挙げられる。とくに、本発明のカーボンナノバルーン構造

体は、粒径が揃っているため、電圧を印加した際に電界強度をほぼ均一に揃え易いから、電子放出素子として好適である。

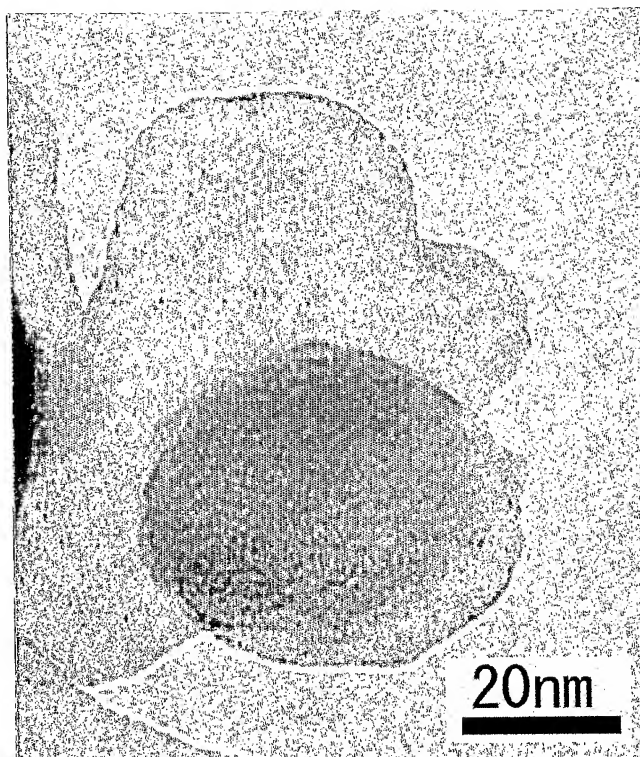


## 請求の範囲

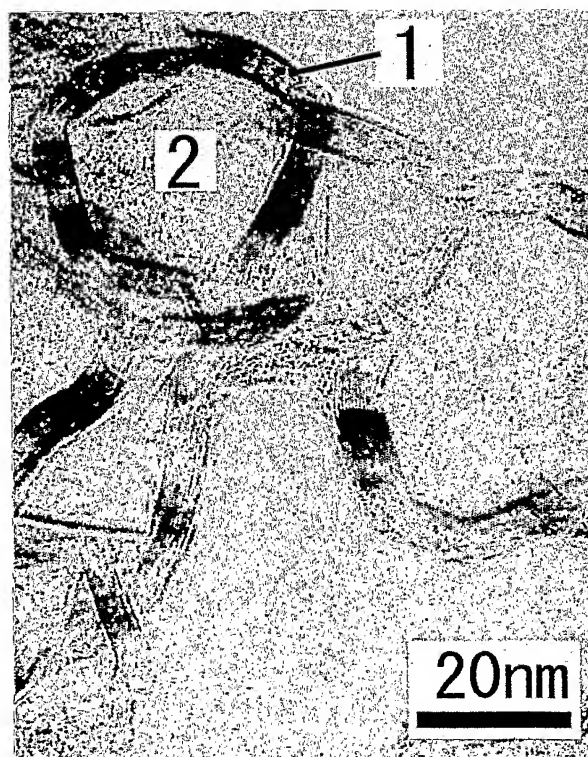
1. グラファイト層が結合して全体として曲面を形成するよう配置された中空構造からなり、その直径が20～500nmであることを特徴とするカーボンナノバルーン構造体。但し、直径とは、構造体の中心を通るようにX軸をとり、該中心を通り且つX軸に直交するようY軸をとり、構造体のX軸方向の長さY軸方向の長さの平均をいう。
2. グラファイト層が1～30層であることを特徴とする請求項1記載のカーボンナノバルーン構造体。
3. 空隙率が30～99%であることを特徴とする請求項1または2記載のカーボンナノバルーン構造体。但し、空隙率は、構造体の中心部を通るようにX軸をとり、該中心を通り且つX軸に直交するようY軸をとり、構造体のX軸方向の長さY軸方向の長さの平均を構造体の直径とし、球形に近似して構造体の体積を求め、該構造体の直径からグラファイト層の厚さの2倍を引いた値を空隙部の直径とし、球形に近似して空隙部の体積を求め、 $(\text{空隙部の体積} / \text{構造体の体積}) \times 100\%$ を計算して求める。
4. 前記構造体が空隙部まで達する開口部が設けられたものであることを特徴とする請求項1～3のいずれかに記載のカーボンナノバルーン構造体。
5. 炭素電極を用いたアーク放電により発生した煤または炭素へのレーザー照射により蒸発した煤、または比表面積が $1000\text{ m}^2/\text{g}$ 以上、一次粒子径が20nm以上のカーボンブラックを、不活性ガス雰囲気中で高温加熱することを特徴とする請求項1～3のいずれかに記載のカーボンナノバルーン構造体の製造方法。
6. 炭素電極を用いたアーク放電または炭素へのレーザー照射を、窒素雰囲気、酸素雰囲気、水素雰囲気、または窒素、酸素および水素のうちの2種以上のガスの混合雰囲気中で行い、発生した煤の一部にカーボンナノホーンを含むことを特徴とする請求項5記載のカーボンナノバルーン構造体の製造方法。
7. 引き出し電極と、該引き出し電極に近接して配置されたエミッタ材料を有するカソード電極の間に電界を印加して電界電子放出を行う電子放出素子において、前記エミッタ材が請求項1～3のいずれかに記載のカーボンナノバルーン構造体

を含んでなる電子放出素子。

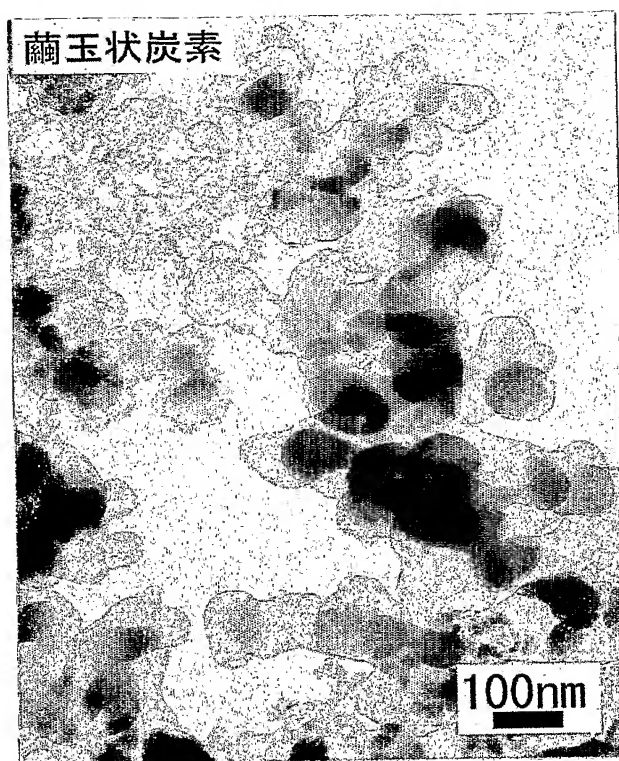
第1図



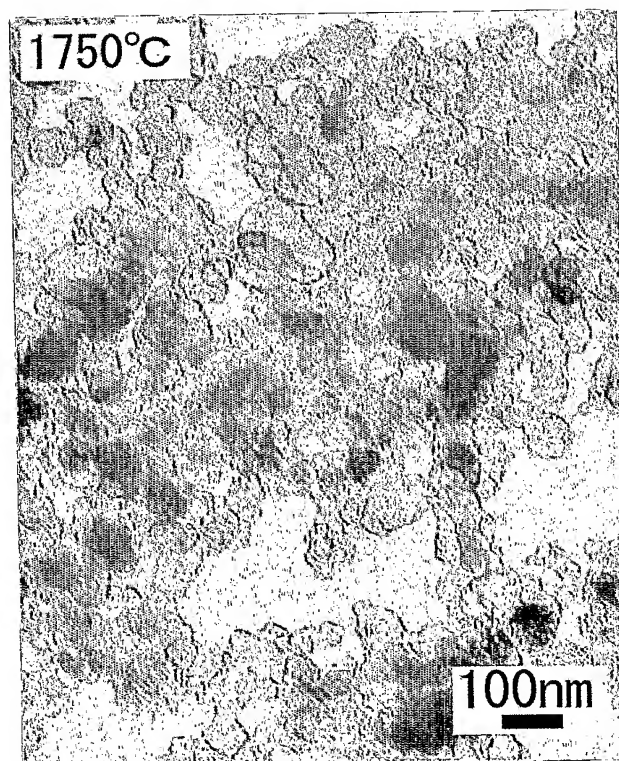
第2図



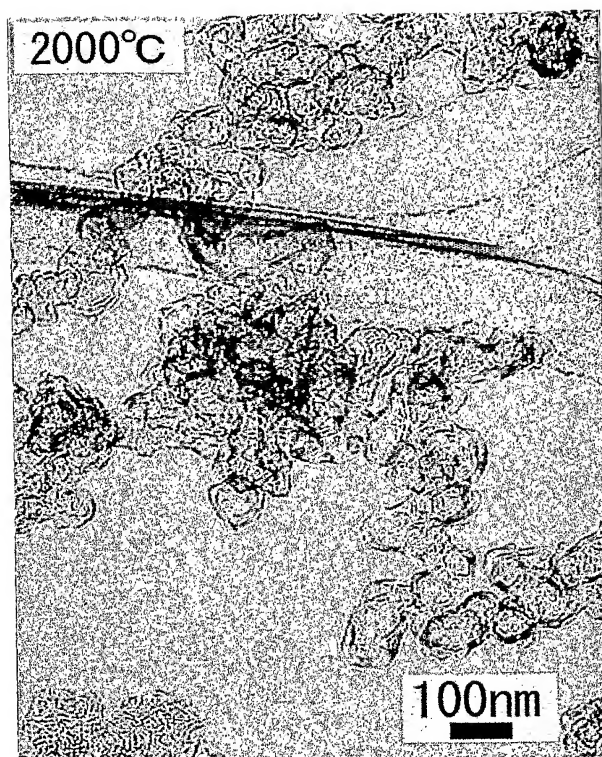
第3図



第4図



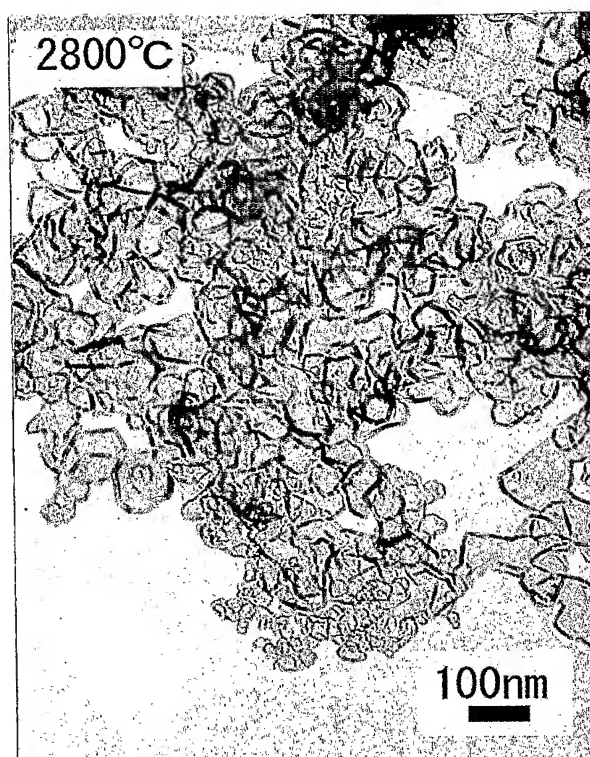
第5図



第6図



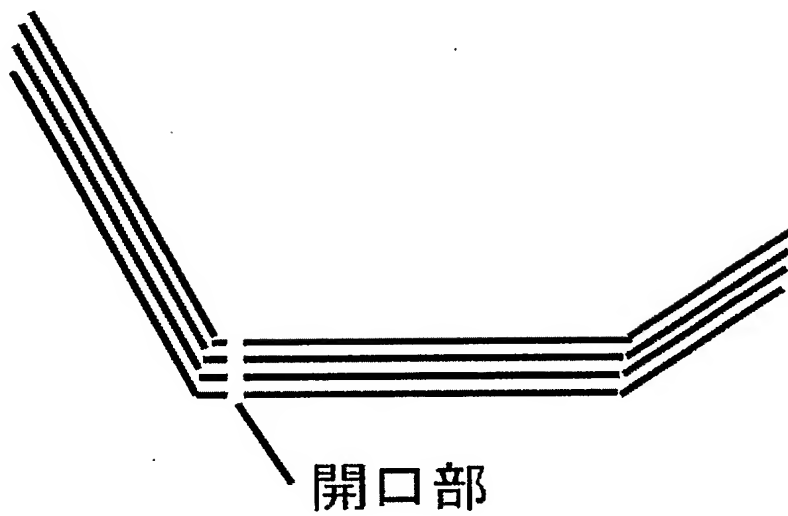
第7図



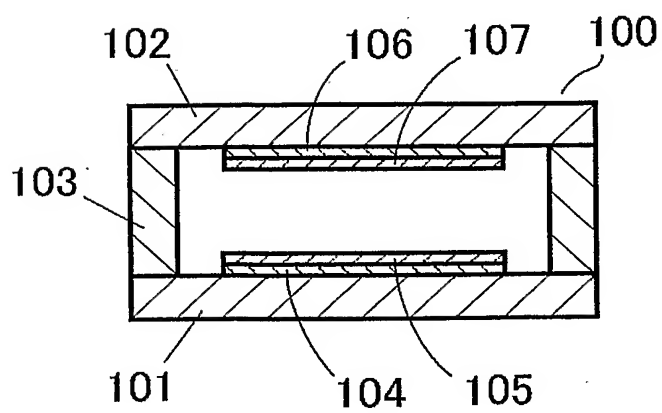
第8図



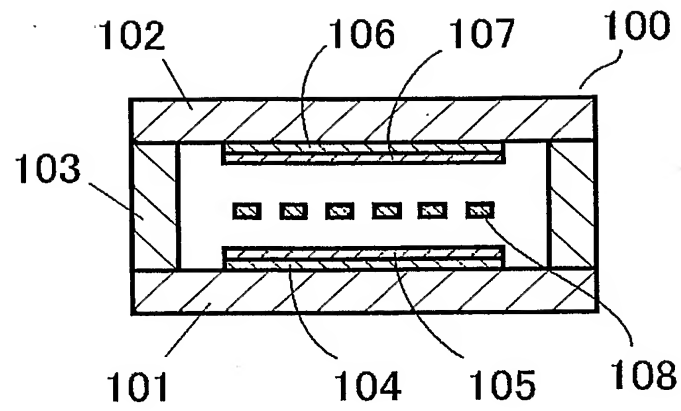
第9図



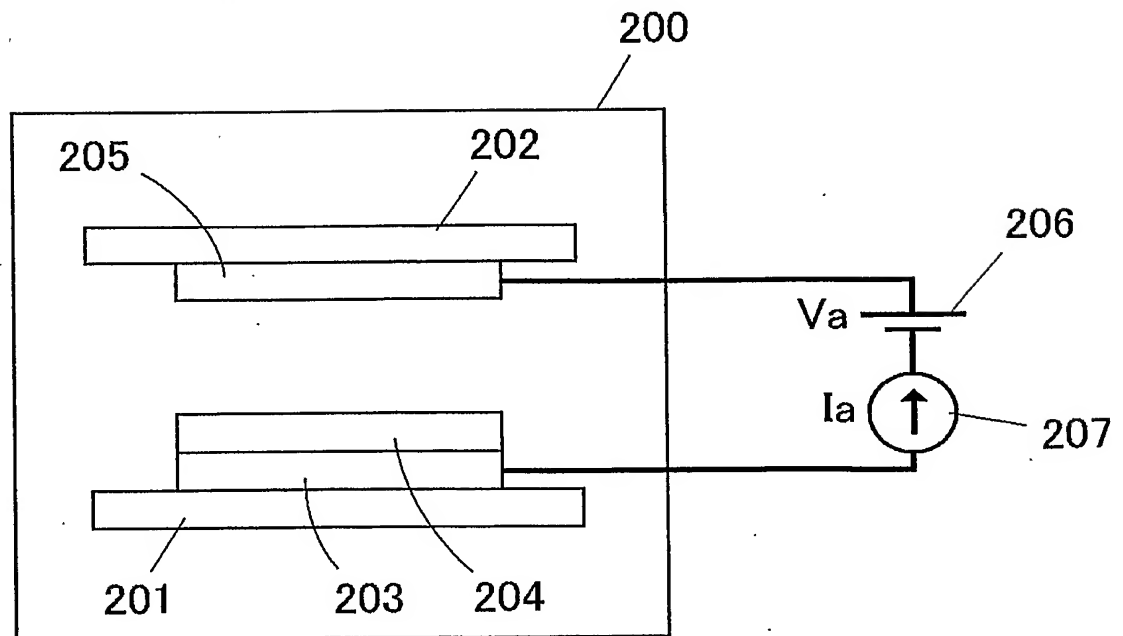
第10図



第11図

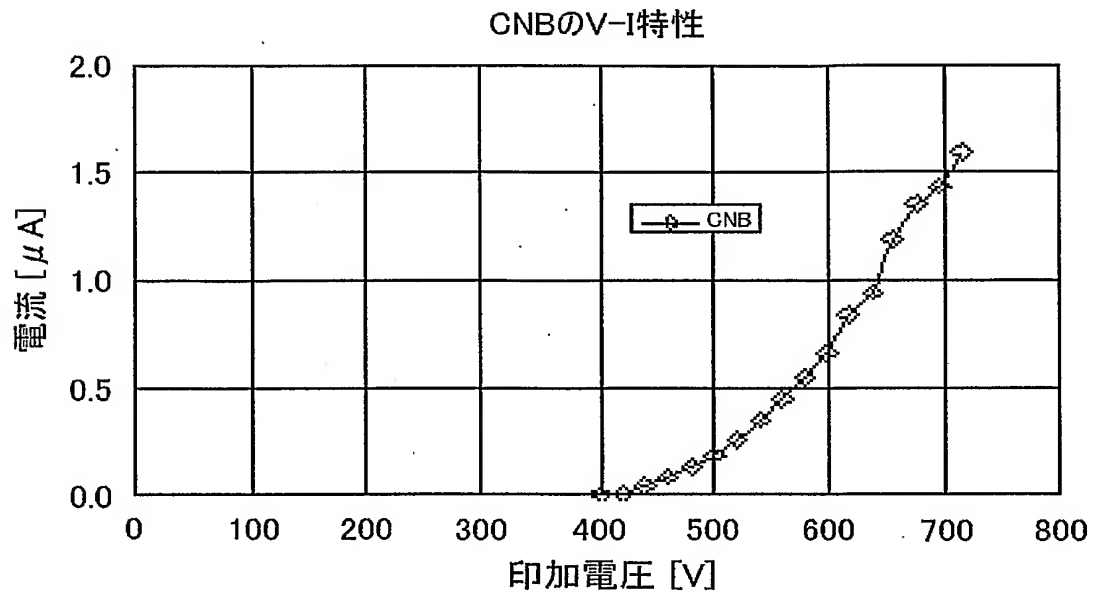


第12図

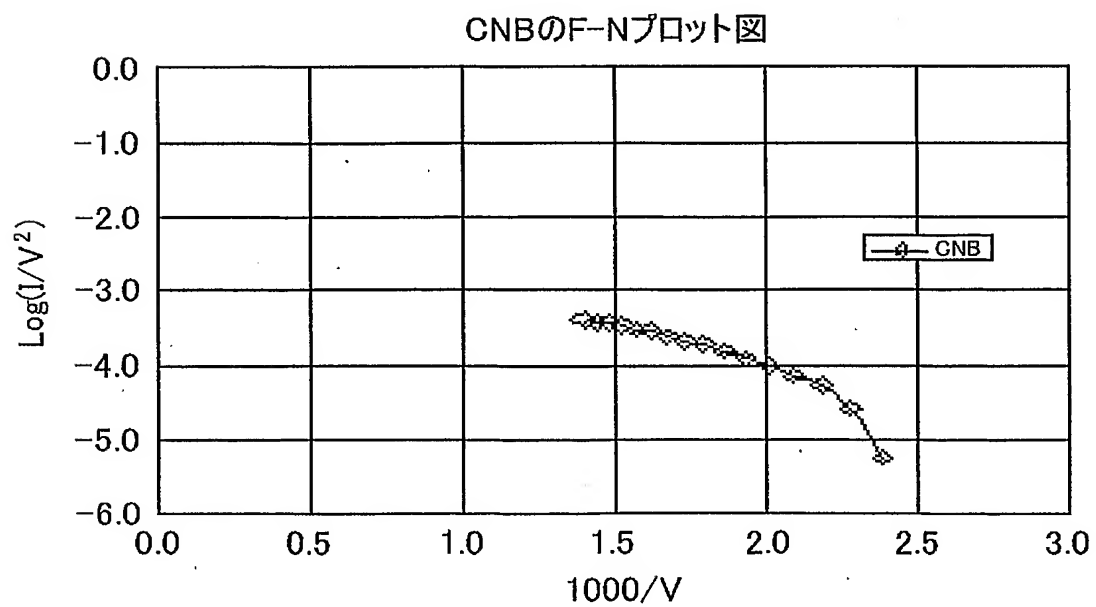




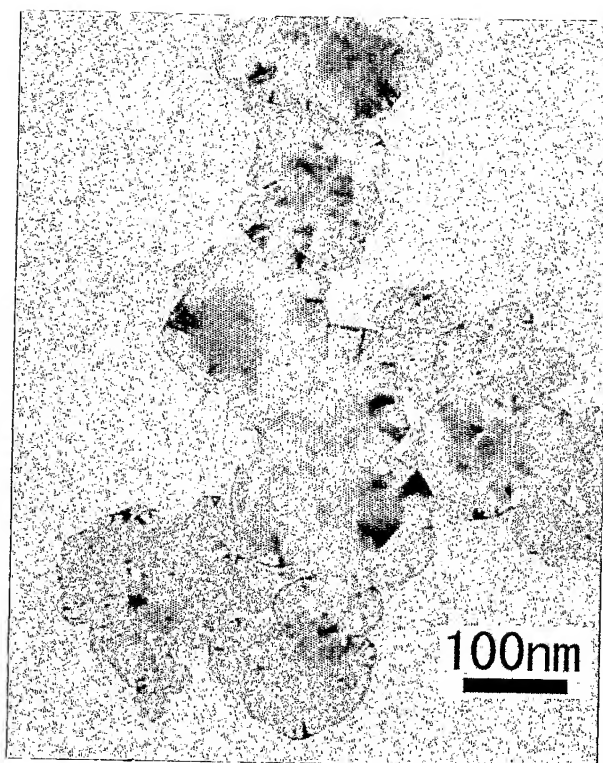
第13図



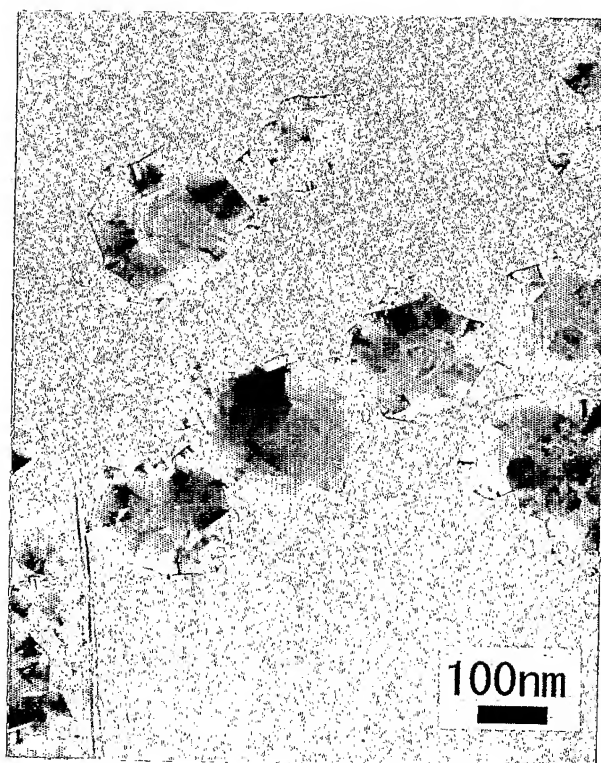
第14図



第15図



第16図



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2005/006441

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER  
Int.Cl.<sup>7</sup> C01B31/02

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
Int.Cl.<sup>7</sup> C01B31/00-31/36Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched  
Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2005  
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2005 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2005

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y A	JP 2003-300713 A (Hiroshi TAKIGAWA et al.), 21 October, 2003 (21.10.03), Par. No. [0071] & US 2003/188963 A1	1-3 4, 7 5, 6
Y	JP 2002-326032 A (Japan Science and Technology Corp. et al.), 12 November, 2002 (12.11.02), Claims 1, 6 & EP 1364704 A1 & US 2004/48744 A1	4
Y	JP 2004-60130 A (Futaba Corp. et al.), 26 February, 2004 (26.02.04), Claim 8 (Family: none)	7



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

\* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&amp;" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search  
30 June, 2005 (30.06.05)Date of mailing of the international search report  
19 July, 2005 (19.07.05)Name and mailing address of the ISA/  
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

## A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl.<sup>7</sup> C01B31/02

## B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl.<sup>7</sup> C01B31/00-31/36

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2005年
日本国実用新案登録公報	1996-2005年
日本国登録実用新案公報	1994-2005年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

## C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	JP 2003-300713 A(滝川浩史, 外2名)2003. 10. 21,	1-3
Y	【0071】	4, 7
A	&US 2003/188963 A1	5, 6
Y	JP 2002-326032 A(科学技術振興事業団, 外2名) 2002. 11. 12, 請求項1, 請求項6 &EP 1364704 A1 &US 2004/48744 A1	4

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

## \* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&amp;」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

30. 06. 2005

国際調査報告の発送日

19. 7. 2005

国際調査機関の名称及びびあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

西山 義之

電話番号 03-3581-1101 内線 3416

4G

3129

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP 2004-60130 A (双葉電子工業株式会社, 外1名) 2004. 02. 26, 請求項8 (ファミリーなし)	7